









	<h2 style="color: red;">IPD65R600E6ATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD65R600E6ATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 7.3A TO252-3
Datenblätter:	 IPD65R600E6ATMA1.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD65R600E6ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 7.3A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 210µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™ E6
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 2.1A, 10V
Verlustleistung (max)	63W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	440pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.3A (Tc)

IPD65R600E6ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD65R600E6ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD65R600E6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD65R600E6ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPD65R420CFDBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 8.7A TO252	 IPD65R600C6 Infineon Technologies IPD65R600C6 Infineon Technologies	 IPD65R650CEAUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7A TO-252	 IPD65R600E6BTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7.3A TO252-3
 IPD65R650CEATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 10.1A TO252	 IPD65R660CFDA INFINEON INFINEON TO-252	 IPD65R600C6ATMA1 Infineon Technologies LOW POWER_LEGACY	 IPD65R660CFD INFINEON IPD65R660CFD INFINEON

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD65R600E6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD65R600E6ATMA1 Datenblatt	IPD65R600E6ATMA1-Datenblätter	IPD65R600E6ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD65R600E6ATMA1
IPD65R600E6ATMA1 Electronic	IPD65R600E6ATMA1-Komponenten	IPD65R600E6ATMA1-Verteiler	IPD65R600E6ATMA1-Bild	IPD65R600E6ATMA1-Teil
IPD65R600E6ATMA1 Preis	IPD65R600E6ATMA1 Hersteller	IPD65R600E6ATMA1 Bild	IPD65R600E6ATMA1 Aktie	IPD65R600E6ATMA1 Inventar
IPD65R600E6ATMA1 Neu	IPD65R600E6ATMA1 Original	IPD65R600E6ATMA1 garantiert	IPD65R600E6ATMA1 RFQ	IPD65R600E6ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited